**Титов, Алексей Васильевич.**

**Исследование электронных локальных центров в цинкосульфидных кристаллофосфорах электрофотографическим методом : диссертация ... кандидата физико-математических наук : 01.04.10. - Одесса, 1983. - 207 с. : ил.**

**Оглавление диссертациикандидат физико-математических наук Ластовка, Владимир Викторович**

**ВВЕДЕН!® ц**

**ГЛАВА I. Ионная имплантация как метод управления электрофизическими и оптическими свойствами соединений**

**W1.1С**

**§ I.I Дефектообразование и термодинамика процессов равновесной самокомпенсации . Ю**

**§ 1.2 Особенности радиационного дефектообразования в л11]/1.**

**§ 1.3 Ионное легирование соединений**

**Выводы. Постановка задачи. .зв**

**ГЛАВА П. Исследование электрических и оптических свойств низкоомных слоев ZnSe ионно-легисованных**

**§ 2.1 Методика получения ионно-летированных индием слоев**

**Zn$e . Измерение электрофизических параметров.**

**§ 2.2 Электрофизические параметры слоев селенида цинка, и онно-ле тированного индием. $ 2.3 Фотолюминесценция селенида цинка, имплантированного индием.«52. $ 2.4 Обсуждение результатов**

**ГЛАВА Ш. Дырочная проводимость селенида цинка, ионно-легиро-ванного мышьяком**

**§ 3.1 Особенности приготовления ионно-летированных слоев Zn$e р-гипа и методика измерения их электрофизических параметров.G**

**Ь 3.2 Электрические и оптические характеристики слоев селенида цинка, ионно-летированного .7J 3.3 Обсуждение результатов.**

**ГЛАВА 1У. Излучающие структуры с барьером Шоттки и имплаятационным р-п-переходом на основе селенида цинка. . ,S2.**

**§4.1 Особенности излучающих структур на основе широкозонных соединений**

**§ 4.2 Технология приготовления и методика исследования излучающих структур. $ 4.3 Сравнительные исследования инжекционной электролюминесценции в структурах с барьером Шоттки и имплантационным р-п-переходом.'/02.**

**§ 4.4 Обсуждение результатов.II**